

東芝フォトカプラ 赤外LED + フォトトランジスタ

# TLP621, TLP621-2, TLP621-4

単位: mm

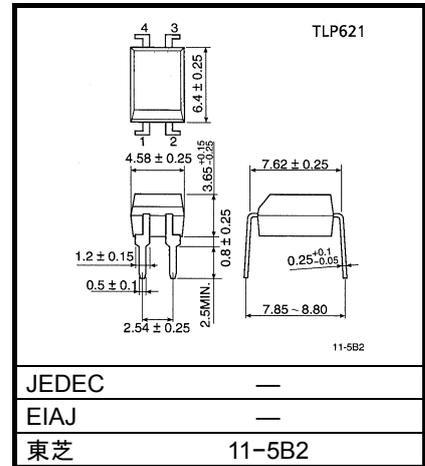
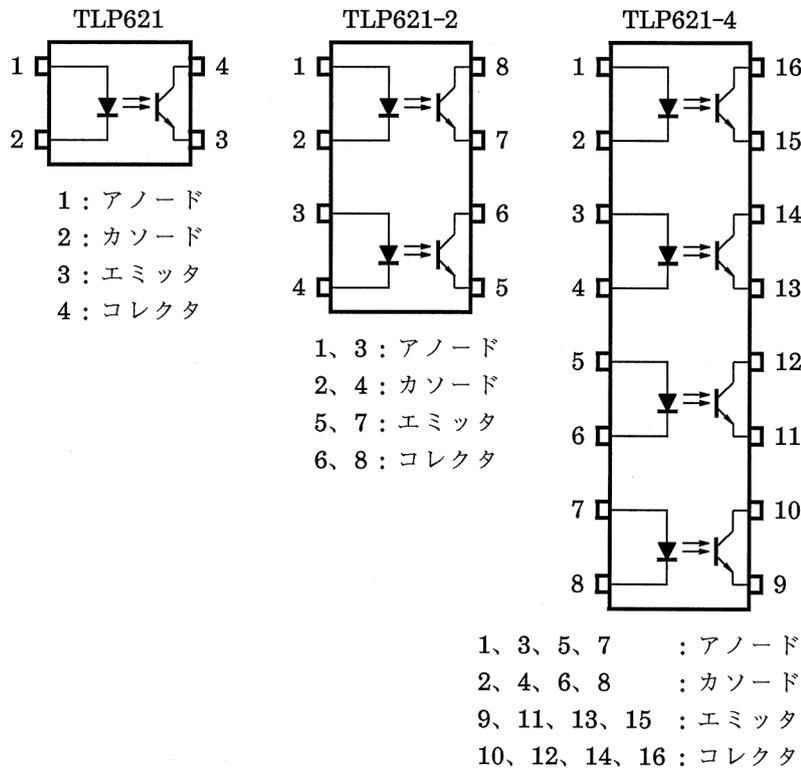
- 電子計算機のI/Oインタフェース
- システム機器や計測器のノイズカット
- 各種コントローラ
- 複写機、自動販売機
- 電位が異なる回路間の信号伝達

TLP621 シリーズは、GaAs 赤外 LED とシリコンフォトトランジスタを組み合わせたフォトカプラで高絶縁耐圧 (交流 5 kVRMS. min) を備えております。

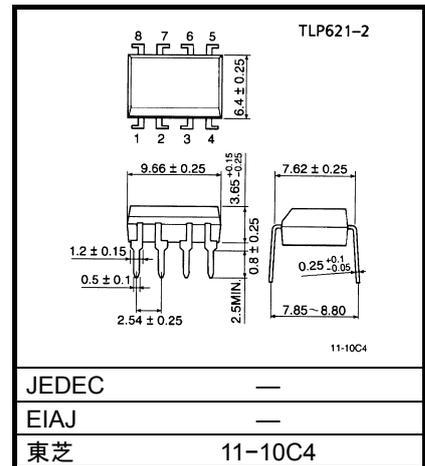
TLP621	DIP	4ピン	1回路
TLP621-2	DIP	8ピン	2回路
TLP621-4	DIP	16ピン	4回路

- コレクタ・エミッタ間電圧 : 55 V (最小)
- 変換効率 : 50% (最小)
- GB ランク品 : 100% (最小)

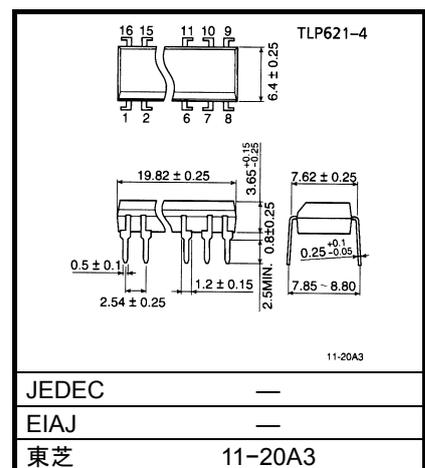
## ピン接続図



質量: 0.26 g



質量: 0.54 g



質量: 1.1 g

## 変換効率

形名	分類名称 (注1)	変換効率 (%) ( $I_C / I_F$ )		製品表示記号
		$I_F = 5 \text{ mA}, V_{CE} = 5 \text{ V}, T_a = 25^\circ\text{C}$		
		最小	最大	
TLP621	無	50	600	無印, Y, Y <sup>■</sup> , G, G <sup>■</sup> , B, B <sup>■</sup> , GB
	Y ランク品	50	150	Y, Y <sup>■</sup>
	GR ランク品	100	300	G, G <sup>■</sup>
	BL ランク品	200	600	B, B <sup>■</sup>
	GB ランク品	100	600	G, G <sup>■</sup> , B, B <sup>■</sup> , GB
TLP621-2 TLP621-4	無	50	600	無印, GR, BL, GB
	GB ランク品	100	600	GR, BL, GB

注 1: 製品形名を指定する場合、形名と分類名称を組み合わせてください。

製品適用例: TLP621 (GB)、TLP621-2 (GB)

注意: 安全規格認定のための形名申請は標準製品形名を使用してください。

(適用例) TLP621 (GB): TLP621

TLP621-2 (GB): TLP621-2

- 絶縁耐圧 : 5000 V<sub>rms</sub> (最小)
- 安全規格

	日本製造品	タイ製造品
UL 認定品	E67349 (*1)	E152349 (*1)
BSI 認定品	6508, 7445 (*2)	
SEMKO 認定品	9808210 / 01-03 (*3)	9808214 / 01-03 (*3)

\*1: UL1577

\*2: BS EN60065: 2002、BS EN60950-1: 2002

\*3: EN60065、EN60950 (認定品は TLP621 と TLP621-2)

- オプション (D4) タイプ  
VDE 認定品: DIN EN 60747-5-2、認定 No. 40009302 (日本製造品)、94767 (タイ製造品)  
最大許容動作絶縁電圧 : 890 V<sub>pk</sub>  
最大許容過電圧 : 8000 V<sub>pk</sub>

注: EN 60747-502 認定品を採用する場合は“オプション (D4) 品”とご指定ください。

- 構造パラメータ

	7.62 mm ピッチ TLP621、TLP621-2、TLP621-4	10.16 mm ピッチ (LF2) タイプ TLP621F(*4)、TLP621F-2(*4)
沿面距離	6.4 mm (最小)	8.0 mm (最小)
空間距離	6.4 mm (最小)	8.0 mm (最小)
絶縁物厚	0.4 mm (最小)	0.4 mm (最小)

\*4: F タイプ品は安全規格申請中です。

## 絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格		単位	
		TLP621	TLP621-2 TLP621-4		
発 光 側	直 流 順 電 流	I <sub>F</sub>	60	50	mA
	直 流 順 電 流 低 減 率	ΔI <sub>F</sub> / °C	-0.7 (Ta ≥ 39°C)	-0.5 (Ta ≥ 25°C)	mA / °C
	パ ル ス 順 電 流 (注2)	I <sub>FP</sub>	1		A
	直 流 逆 電 圧	V <sub>R</sub>	5		V
受 光 側	コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEO</sub>	55		V
	エミッタ・コレクタ間電圧	V <sub>ECO</sub>	7		V
	コレクタ電流	I <sub>C</sub>	50		mA
	コレクタ損失 (1回路)	P <sub>C</sub>	150	100	mW
	コレクタ損失低減率 (Ta ≥ 25°C) (1回路)	ΔP <sub>C</sub> / °C	-1.5	-1.0	mW / °C
動作温度	T <sub>opr</sub>	-55~100		°C	
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55~125		°C	
はんだ付け温度	T <sub>sol</sub>	260 (10秒)		°C	
許容損失	P <sub>T</sub>	250	150	mW	
許容損失低減率 (Ta ≥ 25°C)	ΔP <sub>T</sub> / °C	-2.5	-1.5	mW / °C	
絶縁耐圧 (注3)	BV <sub>S</sub>	5000		V <sub>rms</sub>	

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 2: パルス幅 = 100 μs 以下、周波数 = 100 Hz

注 3: 交流、1分間、R.H. ≤ 60%。LED側ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

## 推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>	—	5	24	V
順電流	I <sub>F</sub>	—	16	25	mA
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	—	1	10	mA
動作温度	T <sub>opr</sub>	-25	—	85	°C

注: 推奨動作条件は、期待される性能を得るための設計指標です。また、各項目はそれぞれ独立した指標となっておりますので、設計の際は電気的特性などで規定された値も合わせてご確認願います。

## 電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位	
発 光 側	順電圧	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 10 mA	1.0	1.15	1.3	V
	逆電流	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = 5 V	—	—	10	μA
	端子間容量	C <sub>T</sub>	V = 0, f = 1 MHz	—	30	—	pF
受 光 側	コレクタ・エミッタ間降伏電圧	V (BR) CEO	I <sub>C</sub> = 0.5 mA	55	—	—	V
	エミッタ・コレクタ間降伏電圧	V (BR) ECO	I <sub>E</sub> = 0.1 mA	7	—	—	V
	暗電流	I <sub>CEO</sub>	V <sub>CE</sub> = 24 V	—	10	100	nA
			V <sub>CE</sub> = 24 V, Ta = 85°C	—	2	50	μA
端子間容量	C <sub>C</sub> E	V = 0, f = 1 MHz	—	10	—	pF	

## 結合特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
変換効率	$I_C / I_F$	$I_F = 5 \text{ mA}, V_{CE} = 5 \text{ V}$ GB ランク品	50	—	600	%
			100	—	600	
変換効率 (飽和)	$I_C / I_F (\text{sat})$	$I_F = 1 \text{ mA}, V_{CE} = 0.4 \text{ V}$ GB ランク品	—	60	—	%
			30	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE} (\text{sat})$	$I_C = 2.4 \text{ mA}, I_F = 8 \text{ mA}$	—	—	0.4	V
		$I_C = 0.2 \text{ mA}, I_F = 1 \text{ mA}$	—	0.2	—	
		GB ランク品	—	—	0.4	

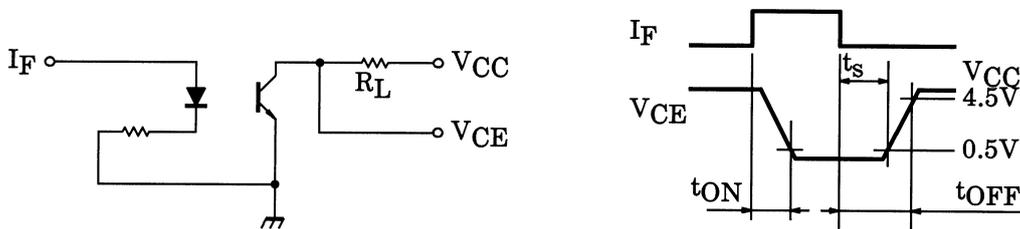
## 絶縁特性 (Ta = 25°C)

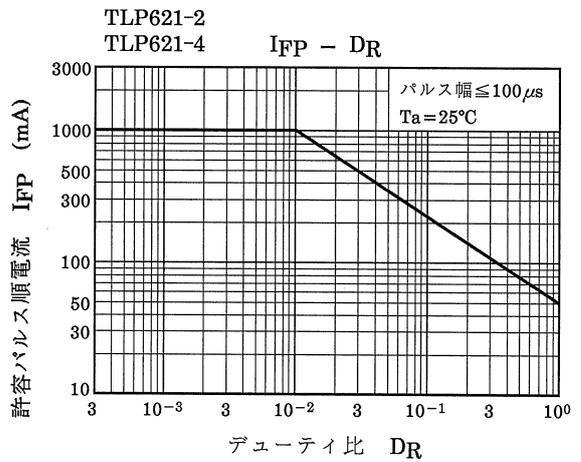
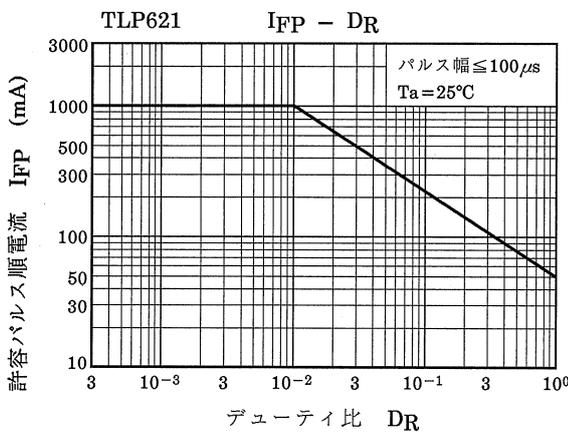
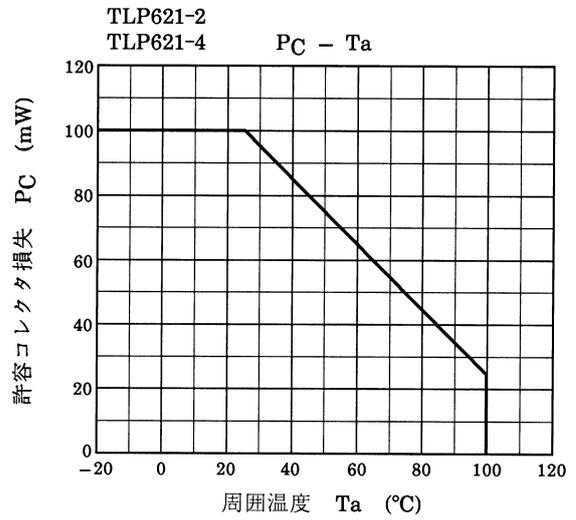
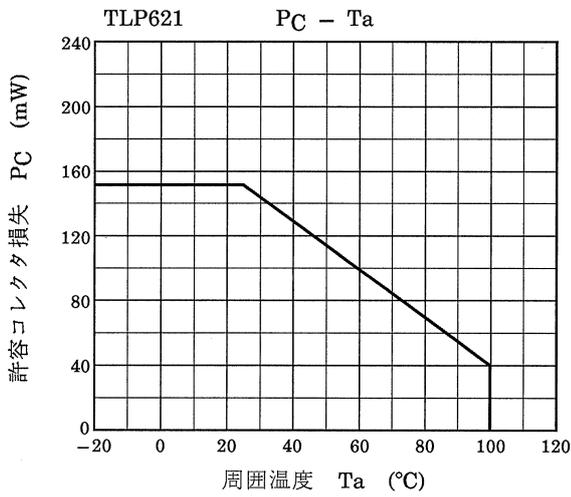
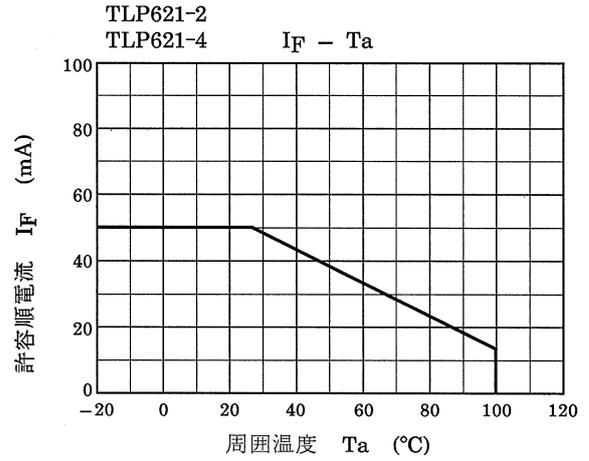
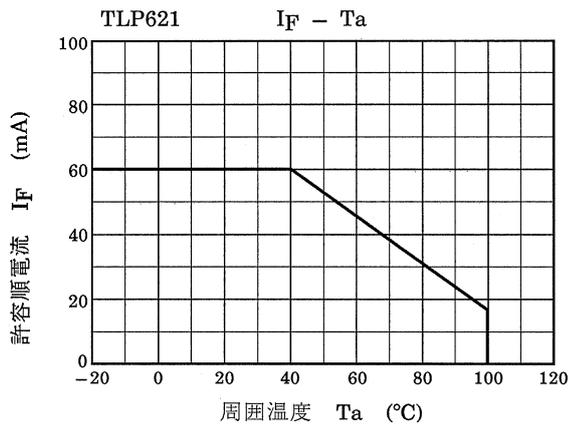
項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
入出力間浮遊容量	$C_S$	$V_S = 0, f = 1 \text{ MHz}$	—	0.8	—	pF
絶縁抵抗	$R_S$	$V_S = 500 \text{ V}, \text{R.H.} \leq 60\%$	$1 \times 10^{12}$	$10^{14}$	—	$\Omega$
絶縁耐圧	$BV_S$	AC、1分	5000	—	—	Vrms
		AC、1秒、オイル中	—	10000	—	Vdc
		DC、1分、オイル中	—	10000	—	

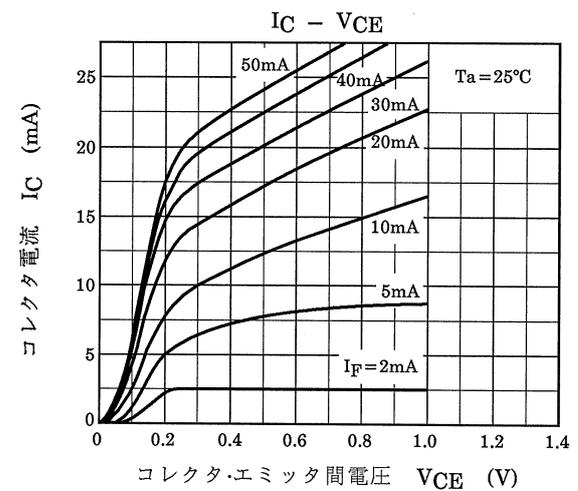
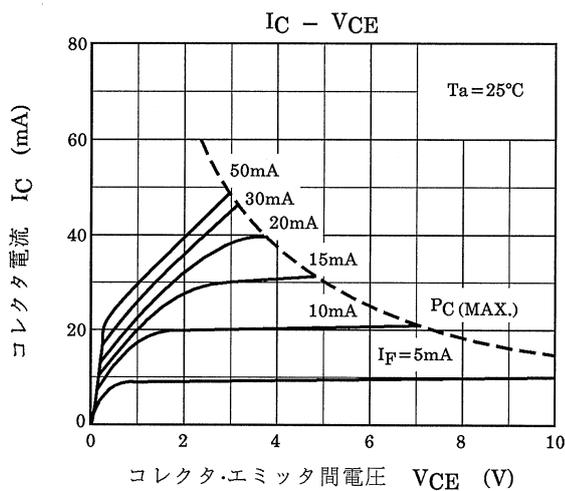
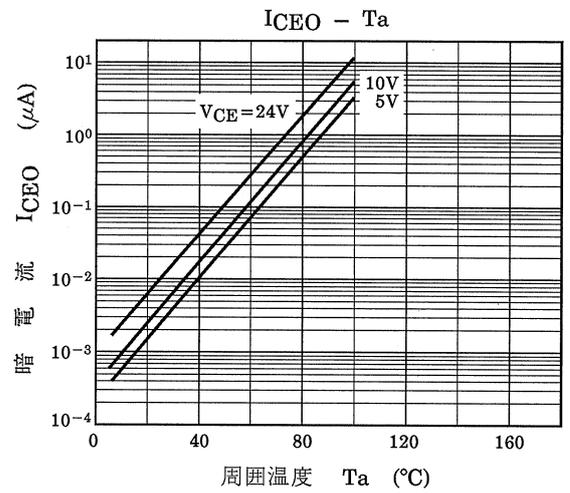
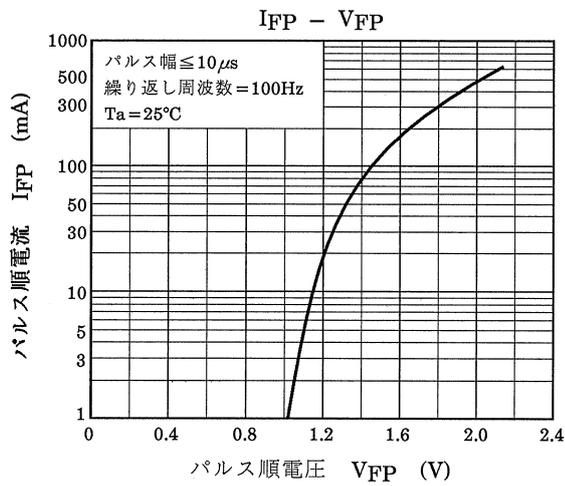
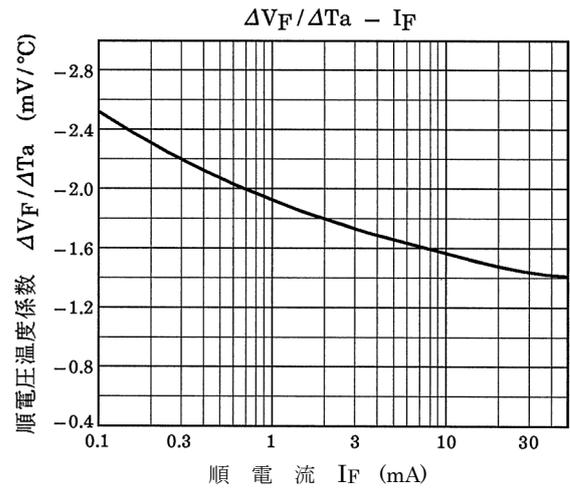
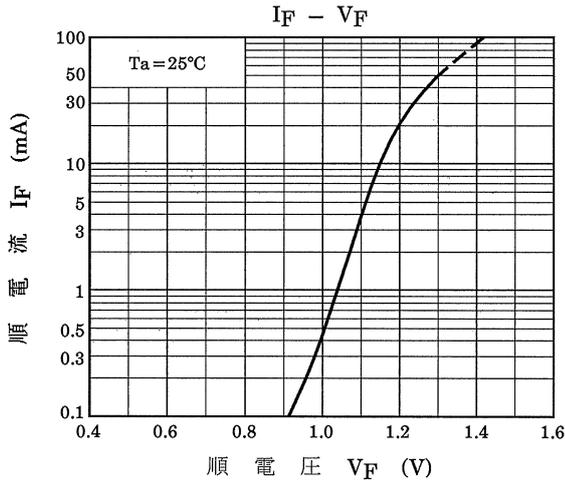
## スイッチング特性 (Ta = 25°C)

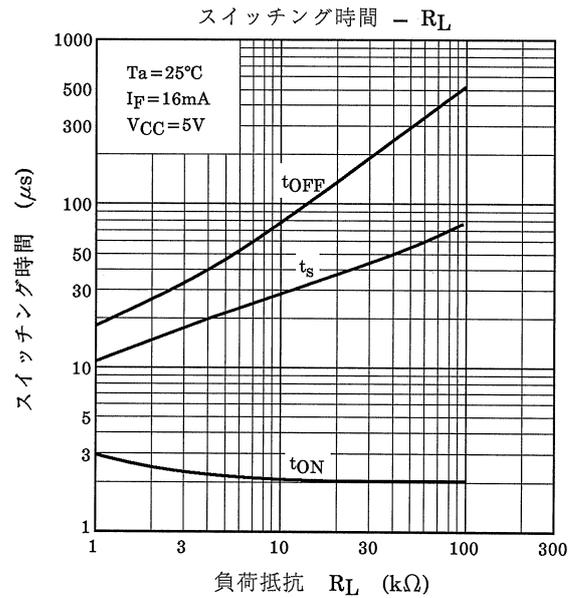
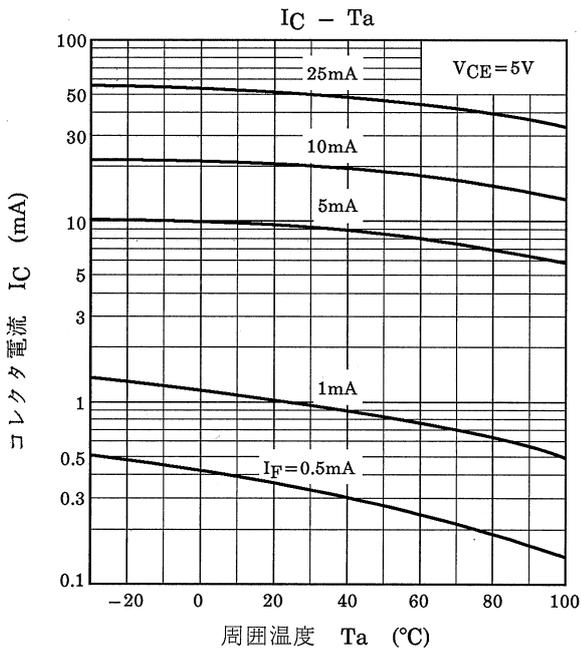
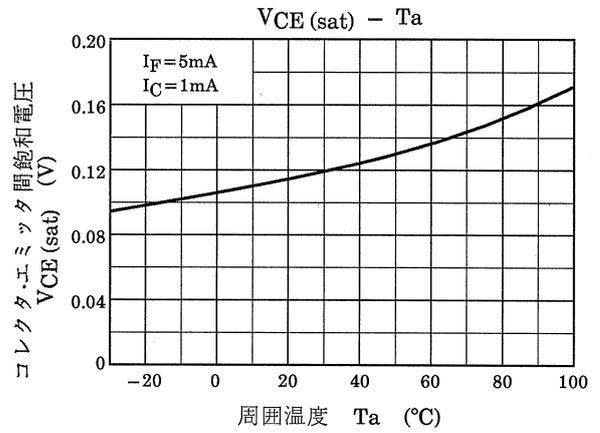
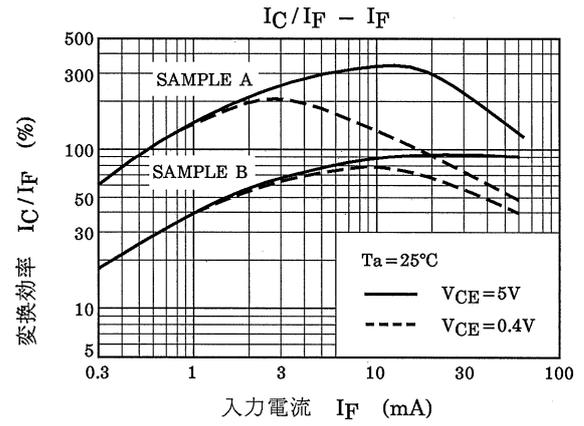
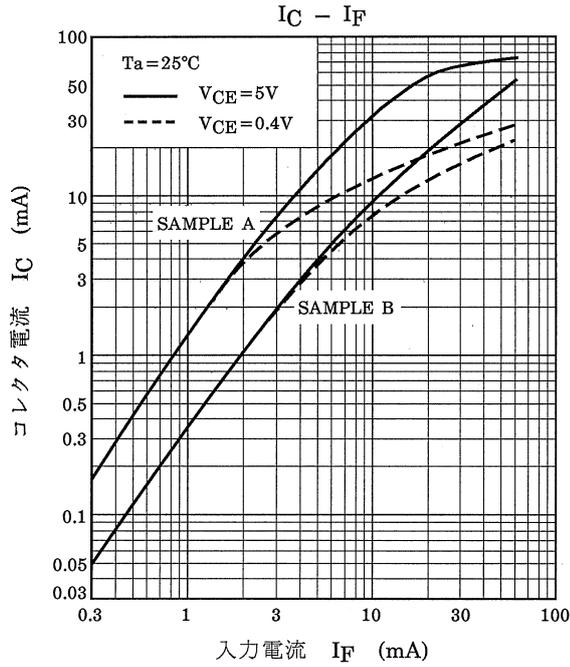
項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
立ち上がり時間	$t_r$	$V_{CC} = 10 \text{ V}, I_C = 2 \text{ mA}$ $R_L = 100 \Omega$	—	2	—	$\mu\text{s}$
立ち下がり時間	$t_f$		—	3	—	
ターンオン時間	$t_{on}$		—	3	—	
ターンオフ時間	$t_{off}$		—	3	—	
ターンオン時間	$t_{ON}$	$R_L = 1.9 \text{ k}\Omega$ $V_{CC} = 5 \text{ V}, I_F = 16 \text{ mA}$ (注4)	—	2	—	$\mu\text{s}$
蓄積時間	$t_s$		—	15	—	
ターンオフ時間	$t_{OFF}$		—	25	—	

注 4: スwitchング時間測定回路









## 当社半導体製品取り扱い上のお願い

20070701-JA GENERAL

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。  
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などでご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則及び命令により製造、使用、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
- 本製品には GaAs（ガリウム砒素）が使われています。その粉末や蒸気は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないで下さい。
- 本資料に掲載されている製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本資料に掲載されている製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令などの法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様が適用される法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。